OPTICAL INFORMATION RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

Publication number: JP4274032 Publication date: 1992-09-30

Inventor:

SAKAMOTO AKITO; INAGOYA OSAMU; MAEDA

TAKESHI

Applicant:

HITACHI MAXELL; HITACHI LTD

Classification:

- international:

G11B7/09; G11B11/10; G11B11/105; G11B7/09;

G11B11/00; (IPC1-7): G11B7/09; G11B11/10

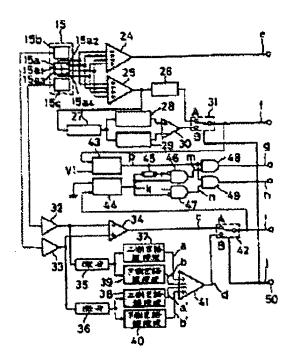
- European:

Application number: JP19910053580 19910227 Priority number(s): JP19910053580 19910227

Report a data error here

Abstract of JP4274032

PURPOSE: To prevent the tracking information signal in ROM area obtained in three-beam system from being influenced by the density of prepit for the optical information carrier in which ROM area and non-ROM are mixed. CONSTITUTION: When the two sub-light beam reproduces ROM area, the alternating components are generated by performing the amplitude modulation by the prepit. In these alternating components, the larger the density in the prepit is, the smaller the amplitude becomes. Therefore, the output signals in photodiodes 15b, 15c receiving sub-light beam are made into the waveform and equalized so that the higher frequency may be, the larger the amplitude may become in differential circuits 35, 36 and the influence by the prepit is removed. A tracking information signal (d) is formed from the alternating component of output signals in the differential circuits 35, 36 by upper side envelope detection circuits 37, 38, lower side envelope detection circuits 39, 40 and an arithmetic amplifier 41.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-274032

(43)公開日 平成4年(1992)9月30日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G11B 7/09

C 2106-5D

11/10

Z 9075-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全10頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-53580

平成3年(1991)2月27日

(71)出願人 000005810

日立マクセル株式会社

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 酒本 章人

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(72)発明者 稲子谷 修

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(74)代理人 弁理士 武 顕次郎

最終頁に続く

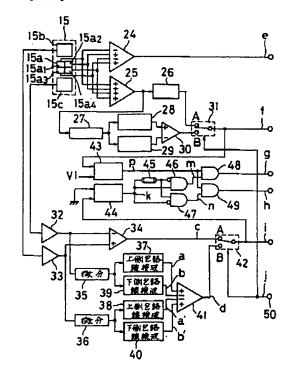
(54) 【発明の名称】 光学情報記録再生装置

(57)【要約】

【目的】 ROM、非ROM領域混在の光学情報担体に 対し、3ピーム方式で得られるROM領域でのトラツキ ング情報信号がプリピツトの密度に影響されないように する。

【構成】 2つの副光ピームがROM領域を再生する と、プリピツトによつて振幅変調されて交流成分が生ず るが、これら交流成分はプリピツトの密度が大きい程振 幅が小さくなる。そこで、副光ピームを受光するフオト ダイオード15b, 15cの出力信号は微分回路35, 36で周波数が高い程振幅が大きくなるように波形等化 され、プリピツトによる影響が除かれる。微分回路3 5,36の出力信号の交流成分から、上側包絡線検波回 路37,38、下側包絡線検波回路39,40及び演算 アンプ41により、トラツキング情報信号 dが形成され る。

【図1】



【特許請求の範囲】

【請求項1】 トラツキングのための案内溝と情報ピツ 下、トとが予め設けられた光学情報担体上に情報記録再生の ための主光ビームとトラツキング検出のための一対の副 し、光ビームを照射し、該光学情報担体上で該副光ビーム夫 なの中心走査軌跡が該主光ビームの中心走査軌跡の両側 に配置されており、該光学情報担体で反射された該副光 ビーム夫々の強度に応じた振幅の電気信号を発生する第 1、第2の光電変換手段と、該第1、第2の光電変換手段の出力信号での該情報ピツトの密度に応じた振幅変化 10 る。 を補償する第1、第2の波形等化手段と、該第1、第2 の波形等化手段の出力電気信号の交流成分を検出し該交流成分の振幅差を検出してトラツキング情報を生成する で予 処理手段とを備え、該第1、第2の波形等化手段が夫々 微分回路であることを特徴とする光学情報記録再生装 置。 で、

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光磁気デイスクや追記 形光デイスクなどのトラツキングのための案内溝が設け 20 られた光学情報担体の光学情報記録再生装置に係り、特 に、トラツキング情報の検出に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、光磁気デイスクや追記形光デイスクなどの光学情報担体には案内溝が設けられ、この案内溝を利用することにより、情報記録再生用ビームのトラッキングを制御するようにした技術が知られている。トラッキング情報の検出方式としては、従来、プッシュプル方式と呼ばれるものが主として用いられている。これは、1つの光ビームを用い、この光ビームが案内溝にかかるときに生ずる±1次回折光の強度差を検出してトラッキング情報を得るようにするものである。

【0003】しかしながら、この方式は光ビームの案内 溝へのかかり具合によつて生ずる±1次回折光の強度差 に応じた光学情報担体からの反射光のファーフィールド パターンの光量分布の変化を利用しているから、光学情 報担体のピーム光軸に対する傾き、案内溝の形状、レン ズ光軸のビーム光軸に対するずれ、光検出器の位置ずれ などの影響を大きく受けることになる。このために、光 学情報担体の機械特性に対する要求が厳しく、また、光 40 学情報記録再生装置に対しても、光学ヘッドの組立て調 整精度、経時変化による部品の位置ずれなどに充分な注 意を払わなければならなかつた。しかも、このような注 意を払つたとしても、トラツク中心軸に対する光ピーム のオフセツトをゼロにすることは困難であるし、また、 レンズシフトを小さくするために、コースアクチユエー タとフアインアクチユエータとを連動されて制御する2 段サーボ方式を採用するなどされており、光学情報記録 再生装置が複雑かつ高価になつていた。

【0004】かかる問題を解消する方式として、3本の 50 の信号が得られる。

光ビームを用いた3ビーム方式が知られているが、以下、この方式を用いた光磁気デイスクに対する従来の光学情報記録再生装置について図10により説明する。但し、1はレーザダイオード、2はコレメートレンズ、3は回折格子、4,5はビーム整形プリズム、6,7はビ

2

ームスプリッタ、8は立上げミラー、9はフオーカスレンズ、10は1/2波長板、11は偏光ビームスプリッタ、12はミラー、13は集束レンズ、14は円筒レンズ、15~17は光給出界、18は光磁気ディスクであ

ズ、15~17は光検出器、18は光磁気デイスクである。

【0005】同図において、レーザダイオード1から水平方向に射出されたレーザビームはコレメートレンズ2で平行ビームとなり、回折格子3で0次回折光と±1次回折光となる。これら回折光は夫々ピーム整形プリズム4,5によつて円形スポツトの光ビームとなる。ここで、0次回折光を主光ビームといい、±1次回折光を副光ビームということにする。また、これらを総称して光ビームということにする。

【0006】ビーム整形プリズム4,5によつてスポット形状が円形とされた光ビームはビームスプリッタ5,6を通り、立上げミラー8で垂直方向に立ち上げられ、フオーカスレンズ9によつて光磁気デイスク18上に集

【0007】光磁気デイスク18上に照射された光ビームはこの光磁気デイスク18で反射される。光磁気デイスク18上に照射される光ビームは光磁気デイスク18上に開射される光ビームは光磁気デイスク18上に情報が磁気的に記録されている領域を照射するとその磁化の大きさに応じたカー効果により、反射光ビームは偏光面が回転してP偏光成分および光ビームの光軸に対して垂直な偏光面のS偏光成分が生ずる。すなわち、反射光ビームはP偏光成分とS偏光成分とからなつており、これらの割合はカー効果の大きさによつて異なる。

【0009】ビームスプリツタ7を透過した反射光ビー ムのP偏光成分はさらにその一部がビームスプリツタ6 で反射され、集束レンズ13で集束される。この集束レ ンズ13で集束される反射光ビームは円筒レンズ14で 非点収差を受け、光検出器15で受光される。光検出器 15は6分割されたフオトダイオードによつて構成され ており、そのうちの4個のフオトダイオードが非点収差 を受けた反射光ビームのうちの主光ビームを受光する。 これらフオトダイオードの出力信号を演算処理すること により、フオーカシング情報が得られる。また、上記 6 10 個のフオトダイオードの残りの2個のフオトダイオード の一方で非点収差を受けた反射光ビームの一方の副光ビ ームを受光し、他方で他方の副光ピームを受ける。そし て、これら2個のフオトダイオードの出力信号の差をと ることにより、トラツキング情報が得られる。

【0010】以上説明した3ピーム方式によると、トラ ツキング情報の検出には、2つの副光ピームの光量差の みを用いているため、ビーム光軸に対するデイスクの傾 きの影響を受けにくく、また、反射された副光ピームを 受光するフオトダイオードからこれら副光ビームの結像 20 スポットがはずれなければよいため、これらフオトダイ オードの位置調整が容易である。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】ところで、光学情報担 体をコードデータの記録に用いる場合には、この光学情 報担体にプリピツトが形成されているが一般的である。 その一例としては、各セクタ毎にアドレス情報を示すへ ツダー部がプリピツトとして形成されている。このよう なピツトが存在するところでは副光ビームの反射光量に すことになるが、ヘツダー部の長さはデータが記録され る領域(データ領域)に比べて充分短かいので、それほ どその影響は大きくない。

【0012】これに対して、データ領域にも予めプリピ ツトでもつてデータを記録したいわゆるROM領域を設 ける場合もある。このようなROM領域からデータを再 生する場合、ヘツダー部だけの場合に比べ、長時間にわ たつてプリピツトにより副光ピームの反射光量が変動し てしまい、正しいトラツキング情報が得られなくなる。 以下、図11~図16により、プリピツトのトラツキン 40 グ情報検出への影響について説明する。

【0013】図11は光学情報媒体の案内溝と3ビーム 方式での各光ピームを示している。案内滯間がデータが 記録されるトラツクである。副光ビームである±1次回 折光は、トラツクと垂直な方向(矢印X方向)で、主光 ビームである0次回折光の両側に1/4トラツクピツチ ずつずれ、かつトラツク方向(矢印Y方向)で、0次回 折光の前後に、トラツクピツチを1.6μmとして、約 40 μmずつずれて光学情報担体を照射する。

【0014】ここで、矢印X方向にみて、+1次回折光 50 ル比較して得られるトラツキング情報信号は、図15で

は0次回折光の右側に、-1次回折光はその左側に夫々 配置されているものとする。各光ビームの反射光量は、 その光ビームの中心がトラツクの中心線に一致したとき 最大となり、案内溝の中心線に一致したとき最小とな る。そこで、いま、光学情報担体が回転しながら0次回 折光、±1次回折光を矢印X方向に移動させた場合、0 次回折光の中心の位置に応じた各光ピームの反射光量を みると、図12に示すように変化する。すなわち、これ らの反射光量はトラツクピツチを周期して変化するが、 +1次回折光の反射光量の変化は0次回折光の反射光量 の変化よりも1/4周期分進み、-1次回折光の反射光 量の変化は逆に1/4周期分遅れている。

【0015】図12はトラツクにプリピツトが形成され ていない場合の各光ビームの反射光量の変化を示してお り、0次回折光の中心がトラツクの中心線に一致してい るとき±1次回折光の反射光量が等しくなり、0次回折 光の中心がトラツクの中心線から1/4トラツクピツチ 分ずれているとき±1次回折光の反射光量の差が最大と なる。

【0016】以上はトラツクにプリピツトが形成されて いない部分を照射する場合であつたが、プリピツトが形 成されている部分を照射する場合には、各光ビームの反 射光はプリピツトによつて強度変調される。この様子を 時間軸 t を基準にして図13, 図14に示す。

【0017】図13は+1次回折光の反射光量の変化を 示し、図14は-1次回折光の反射光量の変化を示して いる。夫々の図において、破線はプリピツトがない場合 の反射光量の変化である。

【0018】プリピツトが存在する場合でも、±1次回 変動が生じ、トラツキング情報の検出精度に影響を及ぼ 30 折光の中心がトラツク中心線に一致するとき、これらの 反射光量が最大となるはずであるが、これはプリピツト の間隔、すなわち密度が一定の場合であり、光学系の分 解能が有限であることから、実際にはプリピツトの密度 は情報内容に応じて変化し、密度が高い程光干渉効果が 大きくなつて反射光量が低下する。このために、±1次 回折光の中心がトラツク中心線と一致しても、必ずしも これらの反射光量は最大とならないし、また、0次回折 光の中心がトラツク中心線と一致しても、±1次回折光 の反射光量は必ずしも一致しない。

> 【0019】そこで、プリピツトの影響を除くために、 ±1次回折光の反射光を受光する光検出器の出力信号を LPF(ローパスフイルタ)に通し、プリピツトによる 変調分を除いて平均値(すなわち、直流成分)を抽出 し、これら直流成分をレベル比較してトラツキング情報 を得ることが考えられる。

> 【0020】しかしながら、得られる直流成分も、図1 3, 図14で平均値として実線で示すように、プリピツ トの変調に応じても、つまり、プリピツトの密度に応じ ても変動しており、このために、これら直流成分をレベ

5

実線で示すようになる。図15において、破線はプリビ ツトがないときの図12の実線で示す±1次回折光の反 射光量から得られる正しいトラツキング情報信号を示し ており、これと比較して明らかなように、正常なトラツ キング情報信号が得られないことになる。

【0021】また、光スポットがピットを通過するとき に得られる再生信号の波形は、図16に示すように、単 峰ガウス型の非対称波形となり、多くの高長波を含んで いる。そこで、COS² 特性をもつトランスパーサルフ イルタなどにより、副光ビームからの電気信号をピツト 10 による影響が補償されるように波形等化することが考え られる。しかし、この方法では、光学情報担体の内、外 周での記録密度差による変調度の差を吸収することがで きず、適当なトラツクで周波数特性を最適化すると、他 のトラツクでは周波数特性に歪みが生じてしまう。これ を防止するためには、少なくとも光学情報担体の内周と 外周ではトランスパーサルフイルタなどの定数を切り替 えることが必要となるが、このようにすると、回路構成 が複雑となり、装置自体が高価になる。

【0022】本発明の目的は、かかる問題点を解消し、 簡単で安価な回路構成でもつて、かつ優れた互換性を維 持しつつ、プリピツトが形成されている領域からも正常 なトラツキング情報が得られるようにした光学情報記録 再生装置を提供することにある。

[0023]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、2つの副光ビーム夫々の反射光量に応じ た振幅の電気信号での光学情報担体上の情報ピツトの密 度に応じた振幅変化を補償する第1、第2の波形等化手 段と、該第1、第2の波形等化手段の出力電気信号の交 30 が反射される。 流成分の振幅差を検出してトラツキング情報を生成する 処理手段とを備え、該第1、第2の波形等化手段を微分 回路とする。

[0024]

【作用】上記のように、プリピツトが形成されている領 域(ROM領域)を副光ピームが走査すると、これらの 反射光はプリピツトによつて強度変調を受け、交流成分 を含む。この交流成分はプリピツトの密度の影響を受 け、プリピツトの密度が高くなるとともに周波数が高く なるが、レベルが低下する。そこで、これら副光ピーム *40* の受光量に応じた電気信号を微分回路に供給すると、こ の電気信号中の交流成分は周波数が高いほどレベルが高 められ、プリピツトの密度によるレベル低下が補償され る。したがつて、夫々の微分回路の出力信号での交流成 分の振幅差を検出することにより、光学情報担体上のR OM領域でのトラツキング情報が得られる。

[0025]

【実施例】以下、本発明の実施例を図1~9によつて説 明する。

の一実施例の光学系を図2、図3により説明する。但 し、図2はその上面図、図3はその側面図であつて、1 9はハーフミラー、20はウオラストンプリズム、21 は集束レンズ、22は光検出器、23はミラーであり、 図11に対応する部分には同一符号をつけている。

6

【0027】図2、3において、レーザダイオード1か ら射出されるレーザビームは、図10に示した従来例と 同様、コリメートレンズ2とピーム整形プリズム4,5 とにより、円形スポツトの平行ビームとなり、回折格子 3で0次回折光(主光ビーム)と±1次回折光(副光ビ ーム)になる。ピームスプリツタ7では、入射される 主、副光ビームにわずかに混在するS偏光成分の全てと P偏光成分の一部を反射し、P偏光成分のみを通過させ る。ビームスプリツタ7を通過した主、副光ビームは立 上げミラー8で立ち上げられ、フオーカスレンズ9で光 学情報担体18上に集束される。

【0028】なお、光学情報担体18上のトラツクピツ チを1.6μmとすると、2つの副光ピームは主光ピー ムのトラツク幅方向左右に 0. 4 μm (トラツクピツチ 20 の1/4倍)、トラツク長手方向前後に約40 μm夫々 ずれて照射される。

【0029】光学情報担体18が光磁気媒体であるとす ると、情報の記録による磁界強度に応じたカー効果が 主、副の反射光ビームに生じ、偏光面が回転してS偏光 成分が生じてその分P偏光成分が減少する。このように 光学情報担体18から反射された主、副光ピームはフオ ーカスレンズ9を通り、立上げミラー8で反射されてビ ームスプリツタ7に入射される。ビームスプリツタ7で は、各回折光のS偏光成分の全てとP偏光成分の一部と

【0030】ビームスプリツタタ7で反射された主、副 光ピームはハーフミラー19で2分され、これで反射さ れた一方の主、副光ビームは1/2波長板10を通り、 ウオラストンプリズム20でP偏光成分とS偏光成分と に分けられる。そして、主光ビームのP偏光成分とS偏 光成分とは集束レンズ21によつて2分割フオトダイオ ードからなる光検出器22の別々のフオトダイオードに **照射される。これらフオトダイオードの出力信号の差を** とることにより、光学情報担体18に磁気記録された情 報信号が得られる、これらフオトダイオードの出力信号 の和をとることにより、光学情報担体18上のプリピツ トによつで生ずる明暗の信号を得ることができる。

【0031】また、ハーフミラー19を通過した他方の 主、副光ピームは集束レンズ13、円筒レンズ14を通 り、ミラー23で反射されて光検出器15に照射され る。光検出器15は4分割フオトダイオードとその両側 に配置された2個の単一のフオトダイオードとで構成さ れており、この4分割フオトダイオードにミラー23で 反射された主光ピームが照射され、2つの単一フオトダ 【0026】まず、本発明による光学情報記録再生装置 *50* イオードの一方にミラー23で反射された一方の副光ビ

ームが、他方の単一フオトダイオードにミラー23で反 射された他方の副光ビームが夫々照射される。

【0032】光検出器15の出力信号からトラツキング 情報信号やフオーカシング情報信号などが形成される が、次に、図1により、これら情報信号の検出手段につ いて説明する。但し、同図において、15aは4分割フ オトダイオード、15a1~15a4はフオトダイオー ド、15b, 15cはフオトダイオード、24, 25は 演算アンプ、26はLPF、27は微分回路、28は上 **側包絡線検波回路、29は下側包絡線検波回路、30は 10 密度が高いほど小さくなる。微分回路35,36は、ア** 差動アンプ、31はスイツチ、32,33はアンプ、3 4は差動アンプ、35,36は微分回路、37,38は 上側包絡線検波回路、39,40は下側包絡線検波回 路、41は演算アンプ、42はスイツチ、43、44は レベル比較回路、45は遅延回路、46~49はアンド ゲート、50は入力端子である。

【0033】光検波器15は4個のフオトダイオード1 5 a 1~15 a 4からなる4分割フオトダイオード15 aとその両側に配置された2個のフオトダイオード15 b, 15cとで構成されており、4分割フオトダイオー ド15aが光学情報担体から反射された主光ピームを受 光し、フオトダイオード15 bが同じく一方の副光ビー ム (たとえば+1次回折光) を、フオトダイオード15 c が同じく他方の副光ピーム(たとえば-1次回折光) を夫々受光する。4分割フオトダイオード15a上に生 ずる主光ビームのスポツトは、この主光ビームが集束レ ンズ13と円筒レンズ14 (図2) を通過しているの で、フオーカスレンズ9が光学情報担体18(図3)に 対してフオーカシング位置にないとき、フオトダイオー ド15a1, 15a4を結ぶ直線方向とフオトダイオー 30 ド15 a 2, 15 a 3を結ぶ直線方向とを夫々軸方向と する楕円形状をなしており、この楕円の2つの軸の比率 が光学情報担体18からフオーカスレンズ9までの距離 に応じて変化する。

【0034】そこで、演算アンプ24により、4分割フ オトダイオード15 a におけるフオトダイオード15 a 2, 15 a 3の出力信号の和からフオトダイオード15 a1,15a4の出力信号の和を減算することにより、 フオーカスレンズ9を制御するためのフオーカシング情 報信号eが得られる。

【0035】フオトダイオード15bの副光ビームの光 --量に応じたレベルの出力信号は、アンプ33で増幅され た後、差動アンプ34と微分器36とに供給される。ま た、フオトダイオード15cの副光ビームの光量に応じ たレベルの出力信号は、アンプ32で増幅された後、差 動アンプ34と微分回路35とに供給される。差動アン プ34では、アンプ33の出力信号からアンプ32の出 力信号が減算され、これら副光ビームの光量差に比例し たレベルの信号cが得られる。この差動アンプ34の出

ない領域(非ROM領域)を主、副光ピームが走査する ときのトラツキング情報である。

【0036】先に説明したように、主、副光ビームが光 学情報担体18上のプリピツトが存在する領域 (ROM 領域)を走査すると、そこから反射される主、副光ビー ムはプリピツトの密度に応じて変調を受け、かつ光量が 変動する。この結果、アンプ32,33の出力信号はプ リピツトの密度に応じた周波数の交流成分を含むととも に、これに交流成分の振幅も影響をうけてプリピットの ンプ32,33の出力信号のかかるプリピツトの密度に よる交流成分の振幅変動を補償し、これら交流成分の振 幅が副光ピームのトラツク幅方向の位置に応じたものと なるように波形等化する。

【0037】微分回路35の出力信号は上側包絡線検波 回路37で検波されてその交流成分の上側包絡線を表わ す信号(上側包絡線信号)aが生成され、また、下側包 絡線検波回路39で検波されて交流成分の下側包絡線を 表わす信号(下側包絡線信号)bが生成される。同様に 20 して、微分回路36の出力信号は上側包絡線検波回路3 8と下側包絡線検波回路40とに供給され、その交流成 分に対する上側包絡線信号a′と下側包絡線検波信号 b'とが生成される。演算アンプ41では (a-b) -(a´-b´)の演算処理がなされる。ここで、(ab) は上側包絡線信号aと下側包絡線信号bとの差であ つて微分回路35の出力信号における交流成分の振幅を 表わし、(a'-b')は、同様にして、微分回路36 の出力信号における交流成分の振幅を表わしている。し たがつて、演算アンプ41から出力される信号 d は微分 回路35,36の出力信号における交流成分の振幅差、 したがつて、主、副光ピームが光学情報担体18上のR OM領域を走査するときのトラツキング情報を表わして いることになる。

【0038】スイツチ42は入力端子50からの制御信 号 j によつて制御され、主、副ビームが光学情報担体1 8上の非ROM領域を走査するときには、A側に閉じて 差動アンプ34の出力信号cをトラツキング情報信号i として選択し、主、副光ピームが光学情報担体18上の ROM領域を走査するときには、B側に閉じて演算アン 40 プ41の出力信号dをトラツキング情報信号iとして選 択する。このトラツキング情報信号iによつて主光ビー ムのトラツキング制御が行なわれる。

【0039】このようにして、光学情報担体18上の非 ROM領域でもROM領域でも良好なトラツキング制御 が可能となるし、プリピツトを形成しない光学情報担体 とプリピツトを設けた光学情報担体との双方に対しても 良好なトラツキング制御が可能となる。

【0040】また、フオトダイオード15b, 15cは 光学情報担体から反射された副光ビームを完全に受光す カ信号 c は、光学情報担体 18 (図 3)のプリピツトが 50 ればよいために、フオトダイオード 15 b , 15 c の配 に等しい時間幅の立上りエツジパルスmが得られ、アン ドゲート47からは同じく立下りエツジパルスnが得ら れる。

10

置など光学系の組立精度が緩和されて安価に光学系を構 成できるし、また、光学情報担体の精度なども緩和でき る。

【0041】次に、図1の他の部分について説明する。 【0042】4分割フオトダイオード15aの各フオト ダイオード15a1~15a4の出力信号は演算アンプ 25で加算され、4分割フオトダイオード15aでの主 光ピームの受光量に比例したレベルの信号が得られる。 演算アンプ25の出力信号は、一方では、LPF26で プリピツトによる変調成分が除去されてスイツチ31に *10* ジパルスnを通過させてトラツク横断信号g,hとす 供給され、他方では、微分回路35,36と同様の機能 を有する微分回路27で交流成分のプリピツトによる振 幅変動が補償された後、上側包絡線検波回路28と下側 包絡線検波回路29と差動アンプ30とによつてこの交 流成分の振幅を表わす信号が生成されてスイツチ31に 供給される。

【0043】ここで、主光ビームが光学情報担体18上 のプリピツトがない領域を走査するときには、LPF2 6の出力信号が4分割フオトダイオード15aが受光す る主光ビームの受光量を表わし、主光ビームが光学情報 20 担体18上のROM領域を走査するときには、差動アン プ30の出力信号が上記主光ビームの受光量を表わす。

【0044】スイツチ31は入力端子50からの制御信 号 j によつて制御され、主光ビームが光学情報担体18 上の非ROM領域を走査するとき、A側に閉じてLPF 26の出力信号を主光ピームの光量信号 f として選択 し、主光ピームが光学情報担体18上のROM領域を走 査するときには、B側に閉じて差動アンプ30の出力信 号を光量信号 f として選択する。

18が装着されて起動するときには、図3のフオーカス レンズ9が下方から持ち上げられて光学情報担体に近づ くが、これとともに4分割フオトダイオード15a上の 主光ビームのスポツトが小さくなつていき、光量信号 f のレベルが上昇していく。光学信号 f のレベルが予め設 定された閾値を越えると、フオーカシンク情報信号eに よるフオーカシング制御が開始する。このようにして、 フオーカシングサーボ回路の起動時の引き込みが迅速に 行なわれるようにする。

【0046】スイツチ42で得られるトラツキング情報 40 信号1は、また、レベル比較回路44で0電位とレベル 比較され、トラツキシグ情報信号iの順次のゼロクロス 点で交互に立上がり、立下る矩形波信号kが生成され る。この矩形波信号 k はアンドゲート 4 6 に供給される とともに、レベル反転されてアンドゲート47に供給さ れる。また、この矩形波信号 k は、遅延回路 4 5 でわず かに遅延された後、レベル反転されてアンドゲート46 に供給されるとともに、アンドゲート47に供給され る。したがつて、アンドゲート46からは矩形波信号k の立上りエツジのタイミングで遅延回路45の遅延時間 50

【0047】一方、スイツチ31で得られる光量信号 f は、また、レベル比較回路43で基準電圧V1と比較さ れ、ゲート信号pが形成される。このゲート信号pはア ンドゲート48, 49に供給される。アンドゲート4 8, 49は夫々光量信号 f が基準電圧V1以上のレベル のときオンとなり、立上りエツジパルスm、立下りエツ

【0048】これらトラツク横断信号g,hは、主光ビ ームが光学情報担体18上のトラツクを横切るように移 動するとき、トラツキング情報信号iのゼロクロスタイ ミングで交互に発生する。しかし、このトラツキング情 報信号iのゼロクロス点は、主光ビームの中心がトラツ ク中心線上にあるときとトラツク間の案内溝の中心線上 にあるときとで生じ、トラツク横断信号g,hの一方が 主光ビームの中心がトラツク中心線上にあるとき生ずる と、他方が主光ビームの中心が案内溝の中心線上にある ときに生じ、しかも、主光ビームの移動方向に応じて主 光ピームの中心がトラツク中心線上にあるときに生する トラツク横断信号が異なる。

【0049】これを判別するために、レベル比較回路4 3から出力されるゲート信号pで制御されるアンドゲー ト48、49が設けられている。すなわち、ゲート信号 pは、主光ビームの中心がトラツク中心線上にあるとき には、必ず高レベルであつてアンドゲート48,49が オンする。従つて、立上りエツジパルスmが主光ビーム 【0045】この光学情報記録再生装置に光学情報担体 30 の中心がトラツク中心線上にあるときに発生すれば、こ の立上りエツジパルスmがアンドゲート48を通過して トラツク横断信号gが得られ、逆に、立下りエツジパル スnが主光ピームの中心がトラツク中心線上にあるとき に発生すれば、この立下りエツジパルスnがアンドゲー ト49を通過してトラツク横断信号hが得られる。

> 【0050】かかるトラツク横断信号gまたはhを計数 することにより、主光ビームが横断したトラツク数を検 出することができ、これにより、トラツクシーク時での 位置、速度を検出することができる。

【0051】図4は図1における微分回路35,36の 一具体例を示す回路図であつて、図示するように、入力 端子と出力端子との間にコンデンサCとインダクタンスデューニー しとが直列接続され、出力端子と接地端子との間に抵抗 Rが接続された構成をなしている。かかる微分回路は、 図5に示すように、周波数fo を極とし、この極よりも 低い周波数領域では周波数fが高くなるとともに振幅が 増大し、この極よりも高い周波数領域では周波数 f が高 くなるとともに振幅が減衰する周波数特性を有してい る。この極 f 。 よりも低い周波数領域内に光学情報担体 での最高記録周波数fmaxがあるように、この微分回

路の周波数特性が設定される。極f。は通常最高記録周 波数 f m a x の 1 0 倍程度に設定すればよい。また、極 f。 よりも髙周波側で減衰させることにより、不要な髙 周波ノイズの増加を抑圧している。

【0052】かかる微分回路によると、最高記録周波数 fmax以下の周波数領域では、周波数fが高い程振幅 が増大する。図6は、光デイスク(光磁気デイスクも含 む) において、記録周波数に対する振幅利得を内周側、 外周側とで別々にプロツトして示したものである。記録 周波数が低い領域では、高調波成分が極めて多く微分回 10 路によつてその高調波成分が強調されるため、振幅利得 が平坦となり、記録周波数が高い領域では、基本波が主 な成分となるから、振幅利得特性は微分特性に近づいて いく。内周側の振幅利得が外周側よりも小さいのは、光 学的分解能のため、内周側で髙調波成分が小さいからで ある。

【0053】そこで、図7に示すように高周波による程 振幅が小さくなる信号が図4に示した微分回路に入力さ れると、髙周波になる程振幅が高められるから、図8に 示すように、この微分回路の出力信号は周波数に関係な *20* く振幅がほぼ一定となる。そこで、かかる微分回路を図 1の微分回路35、36に用いると、図7に示した入力 信号に対して図8で示した出力信号が得られ、この出力 信号をたとえば上側包絡線検波回路37に供給すること により、破線で示すように検波され、ローパスフイルタ で実線で示す上側包絡線信号aが得られる。

【0054】図9は微分回路35、36で波形等化しな い場合の上側包絡線検波回路37,38、下側包絡線検 波回路39,40の入力信号の周波数特性(破線)と、 微分回路35、36で波形等化した場合のこれらの入力 30 ときの各ピームの反射強度を示す図である。 信号の周波数特性(実線)とを比較したものである。同 図でから明らかなように、微分回路35,36で波形等 化することにより、内、外周での利得差はあるが、同一 トラツク内では、プリピツトの密度差に影響されずに平 坦な周波数特性が得られることになる。

【0055】以上のようにして、光学情報担体上のRO M領域でも、良好なトラツキング情報が得られることに なる。

【0056】なお、本発明は、光学情報担体として光磁 気デイスクばかりでなく、追記型の光デイスクなどにも 40 適用することができ、ピツトに影響されないで良好なト ラツキング情報が得られる。

【0057】また、図1において、演算アンプ41は (a-a') もしくは (b-b') の演算処理を行なつ てトラツキング情報信号dを生成するものであつてもよ 61

[0058]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 簡単で安価な回路構成をとりながらかつ優れた互換性を 維持しつつ、光学情報担体のプリピツトが形成されてい 50 42 スイツチ 12

るROM領域や光ピームによつてデータピツトが形成さ れている領域においても、これらプリピツトやピツトに 影響されない良好なトラツキング情報を得ることができ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光学情報記録再生装置の一実施例 の情報信号検出手段を示すプロツク図である。

【図2】本発明による光学情報記録再生装置の一実施例 の光学系を示す上面図である。

【図3】本発明による光学情報記録再生装置の一実施例 の光学系を示す側面図である。

【図4】図1における微分回路の一具体例を示す回路図 である。

【図5】図4で示した微分回路の周波数特性図である。

【図6】図4で示した微分回路による光デイスクの内周 側、外周側での振幅利得を示す図である。

【図7】図4で示した微分回路の入力信号の一例を示す 波形図である。

【図8】図7で示した入力信号に対する図4の微分回路 の出力信号を示す波形図である。

【図9】図1において、微分回路の有無に応じた副光ビ ームからの電気信号の周波数特性を比較して示す図であ

【図10】従来の光学情報記録再生装置の一例の光学系 を示す図である。

【図11】図10における光学情報担体上の3ピームス ポツトの位置関係を示す図である。

【図12】図11において、3ビームスポツトが光学情 報担体上のトラツクを非ROM領域で横切つて移動する

【図13】図11の+1次回折光が光学情報担体上のト ラツクをROM領域で横切るときの反射強度を示す図で ある。

【図14】図11の-1次回折光が光学情報担体上のト ラツクをROM領域で横切るときの反射強度を示す図で ある。

【図15】図13、図14の反射強度の±1次回折光を もとに得られるトラツキング情報信号を示す波形図であ

【図16】ビームスポツトがピツトを通過したときの再 生電圧の波形を示す図である。

【符号の説明】

18 光学情報担体

15b, 15c 副光ピームのフオトダイオード

34 差動アンプ

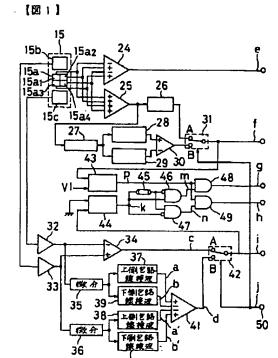
35,36 微分回路

37,38 上側包絡線検波回路

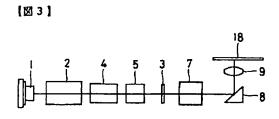
39,40 下側包絡線検波回路

41 演算アンプ

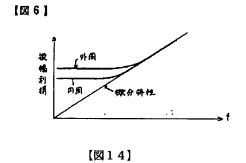
【図1】



[図3]



【図6】

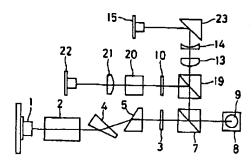


[図14]



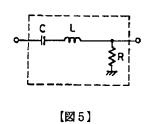
【図2】

[图2]

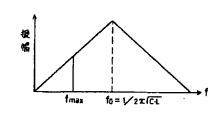


[図4]

【図4】

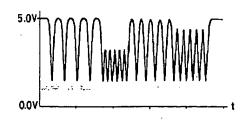


[図5]

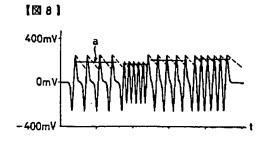


[図7]

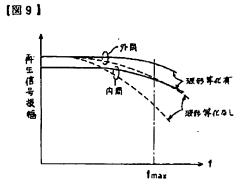




【図8】



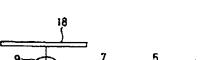
[図9]



【図10】



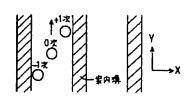
【図10】



9 5 4 3 2 8 13 14 15 16

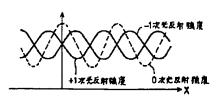
【図11】

【図11】



【図12】

【図12】



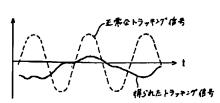
【図13】



【図15】- - ---

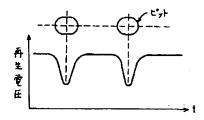
【図15】

[図13]



【図16】

图161



フロントページの続き

(72)発明者 前田 武志

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内